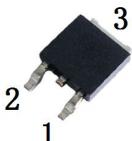


3DD31CT4 型 NPN 硅大功率晶体管

参数符号		测试条件	规范值	单位
	P_{tot}	$T_A=25^\circ C$	1	W
直 流 参 数	I_C		3	A
	I_{CM}		5	A
	T_{jm}		150	°C
	T_{stg}		-55~150	°C
直 流 参 数	$V_{(BR)CBO}$	$I_{CB}=1mA$	≥ 100	V
	$V_{(BR)CEO}$	$I_{CE}=1mA$	≥ 100	V
	$V_{(BR)EBO}$	$I_{EB}=1mA$	≥ 5.0	V
	I_{CEO}	$V_{CB}=60V$	≤ 50	μA
	I_{EBO}	$V_{CE}=5V$	≤ 0.1	mA
	V_{CEsat}	$I_C=3A$ $I_B=375mA$	≤ 1.2	V
	h_{FE}	$V_{CE}=4V$ $I_C=1A$	≥ 25	
		$V_{CE}=4V$ $I_C=3A$	10~50	
外 引 线 说 明	 TO-252			
	1. E 发射极 2. B 基 极 3. C 集电极			
替代型号:MJD31CT4				

筛选:

序号	筛选项目	条 件
1	高温贮存	150 ^o C±2 ^o C, 96h
2	温度循环	-55 ^o C±3 ^o C, 125 ^o C±2 ^o C, 5 次循环
3	功率老炼	老炼条件: $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{CE}=20\text{V}$, $I_C=50\text{mA}$, 8h $T_c=75\pm 5^{\circ}\text{C}$
4	常温测试	按本参数页规定
5	外观检验	打标志之后进行

编制:

审核: (测试条件)
(老化条件)

批准:

日期: